



主な仕様

ナノひずみゲージ	NG-UNI-V3-200K	NG-UNI-V3-1M
a= 受感部の長さ mm	0.1	
b= 受感部の幅 mm	3	
L= 基板の長さ mm	7	
w= 基板の幅 mm	6.5	
抵抗	200k Ω	1M Ω
応答特性	$\Delta R/R_0 = \exp(g \cdot \epsilon) - 1$	
ゲージ率	g : 30	
ゲージ抵抗	R : 200k Ω - 1M Ω	
測定範囲	ϵ : 1~2,000 μ m (ひずみ限界: 0.2%)	
使用温度範囲	T : -40 $^{\circ}$ C to +50 $^{\circ}$ C	
横感度	+40 \pm 10%	

コンディショニング

- 分極電圧: typ0.5~1.5V(cc)
- 可能な構成条件: ホイートストンブリッジ (フルまたはハーフ) 電圧または偏波電流: 線形または対数増幅器